

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ ПЛЕНОК ЖИДКОГО ГЕЛИЯ

Г.И.Салистра

Рассчитана зависимость диэлектрической проницаемости адсорбированной на поверхности твердого тела тонкой плоской пленки жидкого He от толщины пленки, характерной энергии подложки и толщины слоя замерзшего He. Установлена возможность наблюдения эффекта и использования его для определения указанных выше параметров.

Основным параметром плоской пленки жидкого He, адсорбированной на поверхности твердого тела, является ее толщина l . Измерение l тонких пленок с точностью до толщины моноатомного слоя ($3,6\text{Å}$) по-прежнему остается трудной задачей. При обработке полученных различными методами результатов обычно полагают, что пленка однородна и ее диэлектрическая проницаемость (ДП) не отличается от объемного значения ДП.

Покажем, что в действительности ДП тонких пленок жидкого He содержит заметную неоднородную часть $\Delta\epsilon^B$, которая зависит от свойств подложки, толщины замерзшего He и медленно, как $1/l$, убывает с ростом l . Последнее и приводит к заметной величине эффекта для пленок с l , значительно большими толщины моноатомного слоя.

Появление неоднородного вклада в ДП для расстояний от подложки, превышающих атомные размеры, в основном, связано с имеющимся в системе длинноволновым флуктуационным электромагнитным полем. Вклад поля в $\Delta\epsilon^B$ пропорционален среднему квадрату его неоднородной части. Последний, и соответственно, $\Delta\epsilon^B$, неоднороден по толщине пленки и зависит от l и свойств подложки.

Стрикционное происхождение обсуждаемого эффекта и "газоподобность" плотностных и диэлектрических свойств жидкого He позволяет понять заметную величину эффекта в рассматриваемых пленках. Так, сжимаемость жидкого He $\beta_T \approx 1,2 \cdot 10^{-8}$ ед. СГСЭ, что на 1–2 порядка больше, чем у других жидкостей, и стрикционный эффект здесь велик. С другой стороны, обычно измеряемая величина $\epsilon - 1$ (ϵ – ДП He в объеме) здесь $\approx 6 \cdot 10^{-2}$, по сравнению с единицей для типичных жидкостей. В результате измеряемое относительное отклонение ДП – $\Delta\epsilon^B / (\epsilon - 1)$, должно быть достаточно большим.

Рассмотрим пленку с плоскими поверхностями раздела при $x = 0$ на границе твердого тела и при $x = l$ на границе с паром. Учтем, что пленка отделена от подложки слоем твердого He толщиной $D_0 \sim 1 - 2$ атомных слоя. Для ДП пленки $\epsilon(x)$ примем следующую модель: при $x < 0$ $\epsilon(x)$ равно ДП металла ϵ_1 , при $0 \leq x \leq D_0$ оно равно ДП твердого He и в жидкой части пленки при $D_0 \leq x \leq l$ $\epsilon(x) = \epsilon + \Delta\epsilon^B(x)$. Полагаем, что при $x \geq D_0$ $\Delta\epsilon^B(x)$ определяется, в основном, длинноволновым полем и применима общая теория ван-дер-ваальсовых сил¹.

Линейная зависимость ДП He от плотности позволяет представить $\Delta\epsilon^B(x)$ в виде

$$\Delta\epsilon^B(x) = \frac{\epsilon - 1}{\rho} \Delta\rho^B(x), \quad (1)$$

где ρ – плотность объемного He и $\Delta\rho^B(x)$ – определяемый ван-дер-ваальсовыми силами профиль плотности в жидкой части пленки. Для произвольного неоднородного диэлектрика $\Delta\rho^B(x)$ известно²

$$\Delta\rho^B(x) = \frac{T}{4\pi} \rho^2 \beta_T \sum'_{n=0} \omega_n^2 \frac{\partial \epsilon(i\omega_n)}{\partial \rho} D_{II}(\mathbf{r}, \mathbf{r}; \omega_n), \quad (2)$$

где T – температура, $\omega_n = 2\pi nT$, n – целые числа и $D_{II}(\mathbf{r}, \mathbf{r}; \omega_n)$ – неоднородная часть функции Грина фотона при совпадающих значениях аргументов. Для тонких пленок ($l < 30 - 40$ атомных слоев) запаздыванием и температурными эффектами можно пренебречь. После перехода в (2) от $\sum'_{n=0}$ к $\int_0 \frac{d\xi}{2\pi}$ из (1) найдем

$$\Delta\epsilon^B(x) = \frac{(\epsilon - 1)\beta_T}{8\pi^2} \int_0^\infty \xi^2 \left(\rho \frac{\partial \epsilon(i\xi)}{\partial \rho} \right)_T D_{II}(\mathbf{r}, \mathbf{r}; \xi) d\xi. \quad (3)$$

При расчете интеграла в (3) ограничимся слагаемыми первого порядка по $\epsilon - 1$. В этом приближении поверхность раздела жидкий He – пар не вносит вклада в D_{II} ³ и, как и в случае двухфазной системы, жидкий He – твердое тело, D_{II} может быть представлена в виде³

$$D_{II}(\mathbf{r}, \mathbf{r}; \xi) = \frac{\Delta(i\xi)}{2x^3 \epsilon(i\xi)\xi^2}, \quad \Delta(i\xi) = \frac{\epsilon_1(i\xi) - \epsilon(i\xi)}{\epsilon_1(i\xi) + \epsilon(i\xi)}, \quad (4)$$

ϵ_1 – ДП твердого тела. Подстановка (4) в (3) приводит к

$$\Delta\epsilon^B(x) = \frac{(\epsilon - 1)\beta_T}{16\pi^2 x^3} \int_0^\infty d\xi \frac{\epsilon(i\xi) - 1}{\epsilon(i\xi)} \Delta(i\xi). \quad (5)$$

Поскольку жидкий He поглощает в более высокочастотной области, чем подложка, то в принятом по $\epsilon - 1$ приближении (5) можно представить в виде

$$\Delta\epsilon^B(x) = \frac{(\epsilon - 1)^2 \beta_T \hbar \bar{\omega}}{16\pi^2 x^3}, \quad \hbar \bar{\omega} = \hbar \int_0^\infty \frac{\epsilon_1(i\xi) - 1}{\epsilon_1(i\xi) + 1} d\xi. \quad (6)$$

Диэлектрические свойства жидкой части пленки определяются функцией $\Delta\epsilon^B(l)$, которая

представляет собой среднее значение $\Delta\epsilon^B(x)$ по толщине пленки

$$\Delta\epsilon^B(l) = (l - D_0)^{-1} \int_{D_0}^l \Delta\epsilon^B(x) dx. \quad (7)$$

Из (6) и (7) с точностью до слагаемых третьего порядка по малому параметру D_0/l найдем

$$\Delta\epsilon^B(l) = \frac{(\epsilon - 1)^2 \beta_T \hbar \bar{\omega}}{32\pi^2 D_0^3} \left[\frac{D_0}{l} + \left(\frac{D_0}{l} \right)^2 \right]. \quad (8)$$

Таким образом, при $l \gg D_0$ ДП пленки убывает по закону $1/l$. Для различных твердых подложек $\hbar \bar{\omega} \sim 10^{-11} \div 10^{-10}$ эВ, типичное значение для металлов $\sim 3 \cdot 10^{-11}$. Для l и D_0 в атомных слоях

$$\Delta\epsilon^B(l) \approx \frac{10^{-1}}{l D_0^2} \left(1 + \frac{D_0}{l} \right). \quad (9)$$

Для пленок с $l \sim 5 - 30$, $\Delta\epsilon^B(l) \sim 10^{-2} \div 10^{-3}$, что сравнимо с измеряемой $\epsilon - 1 \sim 6 \cdot 10^{-2}$. Это обстоятельство и специфическая зависимость $\Delta\epsilon^B(l)$ от l и D_0 делают необходимым учет обсуждаемого эффекта при измерении ДП тонких пленок.

Пусть пленка Не адсорбирована на поверхности металла, которая используется в качестве одной из обкладок конденсатора с расстоянием между обкладками $d \gg l$. С точностью до слагаемых $\sim D_0/d$ разность между емкостями рассматриваемого $C(l, d)$ и пустого $C(d)$ конденсаторов имеет вид

$$\frac{C(l, d) - C(d)}{C(d)} \approx 6 \cdot 10^{-2} \frac{l}{d} + \frac{10^{-1}}{D_0^2 d} + \frac{10^{-1}}{D_0 d}. \quad (10)$$

В пренебрежении $\Delta\epsilon^B(l)$ рассматриваемая разность — линейная функция l , которая обращается в нуль при $l = 0$. Второе слагаемое в (10) оставляет разность емкостей линейной функцией l , не проходящей, однако, через начало координат. Третье слагаемое существенно лишь для предельно тонких пленок и увеличивает отклонение емкости от его значений для однородной пленки. При $l \sim 10$ и $d \sim 10^3$ оба обсуждаемых слагаемых доступны наблюдению. Выражение (10) удобно представить в виде

$$\frac{C(l, d) - C(d)}{C(d)} \approx 6 \cdot 10^{-2} \frac{\tilde{l}}{d}, \quad \tilde{l} = l + b, \quad b = \frac{10}{6D_0^2}. \quad (11)$$

Здесь \tilde{l} — определяемая емкостным методом толщина пленки, которая на величину $b \sim 1 - 2$ атомных слоя больше ее действительного значения l .

Второе слагаемое в (9) может быть наблюдаемо при измерении разности емкостей конденсаторов с одинаковым расстоянием между обкладками и толщиной пленок l_1 и l_2

$$\frac{C(l_1, d) - C(l_2, d)}{C(d)} = \frac{\epsilon - 1}{d} (l_1 - l_2)(1 - \sigma), \quad \sigma = \frac{10}{6D_0} \frac{1}{l_1 l_2}. \quad (12)$$

При $l_1, l_2 \sim 10^2 \div 10^3$, $\sigma \sim 5 \cdot 10^{-2} \div 10^{-3}$ и вклады в емкость $\sim 1/l$ доступны наблюдению.

Таким образом, при учете нелинейных свойств жидкого Не (стрикции) длинноволновое флуктуационное электромагнитное поле подложки приводит к тому, что ДП пленки неоднородна, зависит от ее толщины, характерной энергии подложки и параметра D_0 . "Газоподобность" жидкого Не и достигнутая ныне высокая точность емкостных измерений делают возможным наблюдение эффекта и позволяют использовать его для определения с высокой точностью величин l , $\hbar \bar{\omega}$ и D_0 .

Автор благодарен А.Ф.Андрееву, В.Л.Покровскому, Д.Е.Хмельницкому, А.М.Дюгаеву и В.И.Панову за полезное обсуждение настоящей работы.

Литература

1. Дзялошинский И.Е., Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. УФН, 1961, 73, 381.
2. Салистра Г.И. Изв. высш. уч. зав., сер. Физика, 1976, № 12, 73.
3. Пухица П.В., Салистра Г.И. Изв. высш. уч. зав., сер. Физика, 1981, № 9, 16.
4. Anderson C.H., Sabisky E.S. Phys. Rev. A, 1973, 7, 790.

Одесский государственный университет

Одесский государственный университет
им. И.И.Мечникова

Поступила в редакцию

21 июля 1986 г.

После переработки

7 ноября 1986 г.